

# 半 导 体 学 报

第 5 卷 第 4 期 1984 年 7 月

## 目 录

流体静压力下的 Si 中的深杂质能级 .....	夏建白 (345)
a-Si:(Cl,H) 薄膜的 PESIS 研究 .....	邢益荣 钟战天 沈光地 (353)
多晶硅中碳化物及其来源的研究 .....	万 群 李玉珍 徐宝琨 赵慕愚 (360)
原生直拉无位错硅单晶中漩涡缺陷的观察 .....	
.....	钱家骏 褚一鸣 范缙文 林兰英 (368)
二毫米雪崩二极管微波振荡器 .....	杨玉芬 刘衍芳 (374)
GaAs 体效应器件中阴极深凹槽掺杂分布引起静止畴的超宽带负阻 .....	
.....	郑一阳 张进昌 (380)
MOSFET 强表面场电学特性分析 .....	刘可辛 傅 予 李 宏 (388)
LSI 二维布局的分析算法 .....	周 电 唐璞山 (396)
快速最优通道布线算法 .....	吴祖增 (404)
LSI 多元胞版图设计的一种布局方法 .....	沙 露 唐璞山 (412)
双边单元的 LSI 自动布局算法 .....	程可行 庄文君 (422)
可编程逻辑阵列的折迭和版图自动生成 .....	赵文庆 唐璞山 (431)

## 研 究 简 报

关于 MOS 结构深耗尽 $c(v)$ 特性的转折现象 .....	马鑫荣 李志坚 (440)
用 MOS 恒定电荷法测定半导体少子的体产生寿命及表面产生速度 .....	
.....	谭长华 许铭真 (443)
Al-SiO <sub>2</sub> -Si/n 系统的 $\gamma$ 辐照界面效应及退火特性 .....	张秀森 顾 峰 谢可勋 (449)
$K_{CMR}$ 的一个测试方法 .....	李光宇 (453)

\* \* \*

### 本刊第 5 卷第 3 期勘误

页	行	误	正
236	1	双光束条件, 衍射矢量 $g = [400]$ .	双光束条件, $S \geq 0$ , 衍射矢量 $g = [400]$ .
257	9	$\geq$	$\leq$
257	11	$1 \times 10^6$	$1 \times 10^{16}$
289	2	表 2	表 1
312	倒 7	$(10)^{[4]}$	$(10)$
318	倒 18	50%	43%
325	10	$4 \times 10^2$	$4 \times 10^{21}$